

**关键指标**

频率: 2~6GHz  
增益: 26dB  
3dB 压缩点输出功率: 27dBm@5V, 28dBm@6V  
电压/静态电流: +5V/240mA, +6V/240mA  
芯片尺寸: 1.55mm×1.6mm

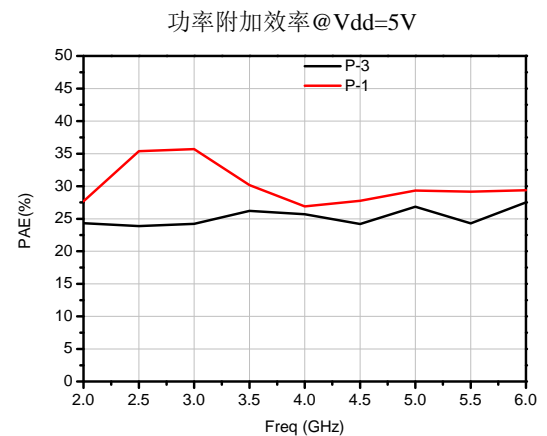
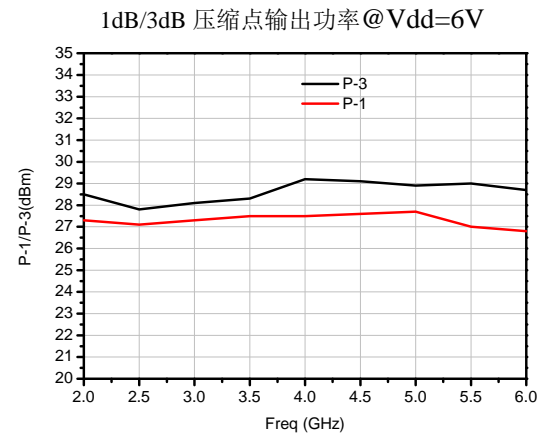
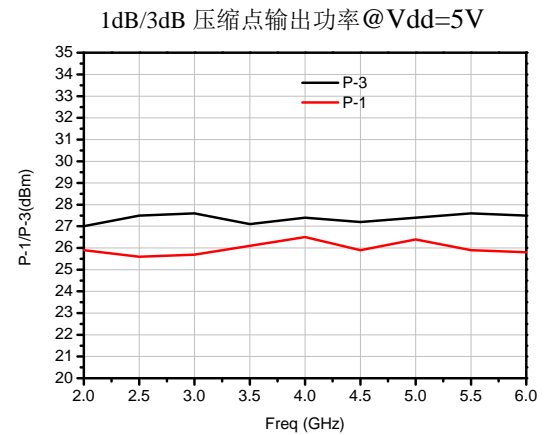
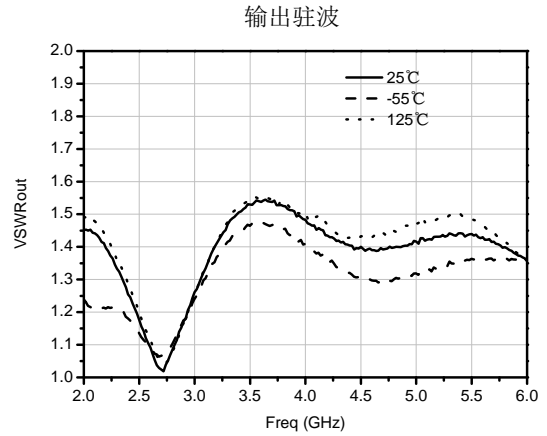
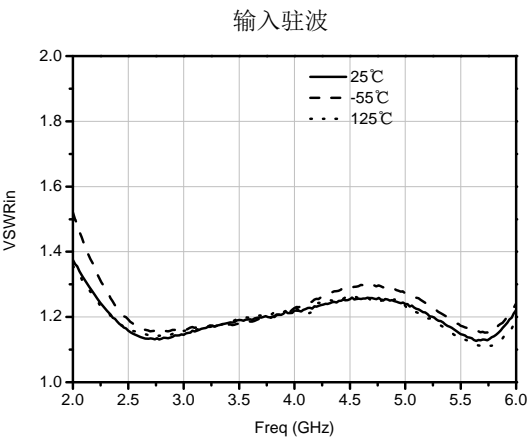
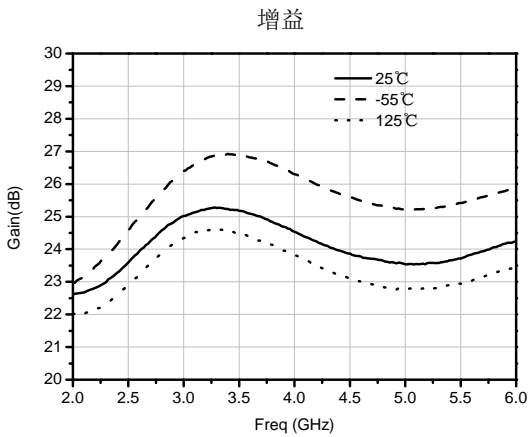
**产品简介**

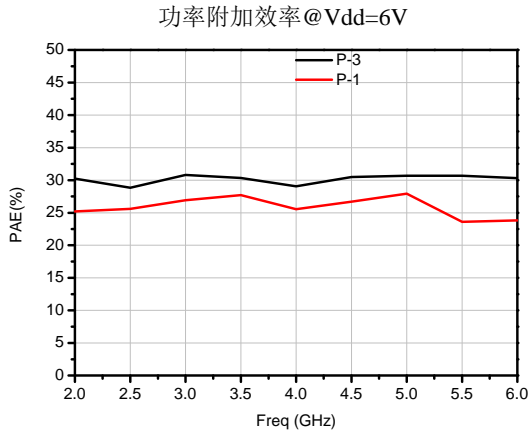
HG124F6 是一款 2~6GHz 驱动放大器芯片, 增益为 26dB, 可用于+5V 或+6V, +5V 加电时, 输出功率即可达到 27dBm。

**电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>dd</sub>=5V, V<sub>G</sub>=-0.67V)**

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	2~6		
增益(dB)	-	26	-
增益平坦度(dB)	-	±1.5	-
输入驻波	-	1.2	-
输出驻波	-	1.4	-
1dB 压缩点输出功率(dBm)	-	27	-
3dB 压缩点输出功率(dBm)	-	28	-
3dB 压缩点效率 (%)	-	30	-
静态电流 (mA)	-	240	-

**典型测试曲线**





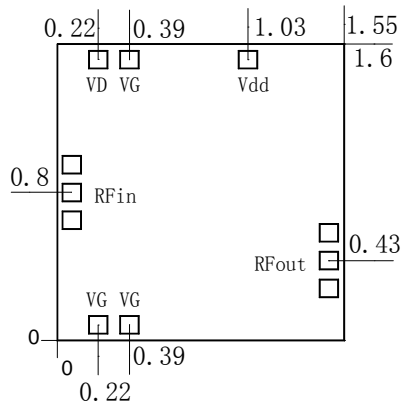
绝对额定最大值

工作电压	+8V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

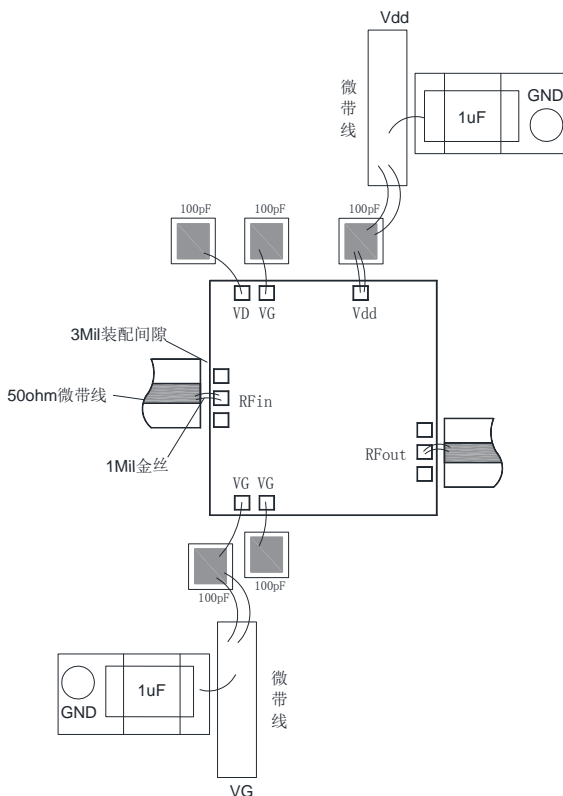
注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25 \mu m$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400  $\mu m$ ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



- 注：1. 三个 VG 任选一个加电，另两个通过 100pF 电容到地。  
2. 滤波电容要离芯片压点尽量近，尽量减少金丝长度影响。